

# СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОФИЛИРОВАННЫХ МЕМБРАН ДЛЯ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНЫХ УСТАНОВОК

Н.Д. Чичирова<sup>1</sup>, О.Е. Бабиков<sup>2</sup>, А.Ю. Власова<sup>3</sup>

ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань, Республика Татарстан

<sup>1</sup>ndchichirova@mail.ru, <sup>2</sup>Olegsey1998@yandex.ru, <sup>3</sup>vlasovaay@mail.ru

В статье приведены несколько способов производства профилированных мембран, используемых для процесса электродиализа.

**Ключевые слова:** электродиализ; профилированные мембранные; ионообменные мембранны; 3D-печать; мембранные литье; термопресс.

Современные профилированные мембранны, нашедшие применение в процессах электродиализа и обратного электродиализа, значительно повышают показатели экономичности и эффективности мембранных модулей.

На данный момент известны три способа производства профилированных мембран: термический метод (термопресс), мембранные литье и 3D-печать[1].

Термический метод заключается в том, что сначала сухую плоскую гетерогенную мембрану помещают между формой и прессом. Затем в термопрессе мембрана нагревается. По мере нагревания пресс давит на мембрану, придавая ей необходимую форму и размер. Термический метод производства мембран увеличивает удельную проводимость гетерогенной ионообменной мембранны (на примере Ralex АМН-РЕС) с 9,1 до 13,9 мСм/см [2]. Придать данным методом профилированную форму можно лишь гетерогенной ионообменной мемbrane. Чтобы обеспечить легкое высвобождение мембранны из формы, можно первоначально распылять на поверхность специальные антиадгезивы. Другим важным условием является то, что высота мембранны не должна быть больше, чем ее ширина [3].

Мембранные литье применяется как для гомогенной, так и для гетерогенной ионообменной мембраны. Исходной раствор мембраны заливается в форму. Толщину мембраны можно регулировать, изменяя объем мембранообразующего вещества, размер профиля зависит от используемой формы. Метод мембранного литья основан на испарении растворителя и кристаллизации самого мембранного материала. Главным

Ли - Г. Д. Чекулаев / Людмила А. П. Басова /  
Дж. Бабиков О.С.